

## Daniel Nagy



INVESTIGADOR POSTDOUTORAL

### Bio

Obtive o título de Enxeñeiro en Electricidade e Electrónica na Universidade de Swansea (Reino Unido) en 2011, e o Máster en Nanociencia e Nanotecnoloxía na mesma universidade en 2013, onde completei satisfactoriamente os meus estudos de doutoramento en 2016. Entre os meus intereses en investigación destaca o transporte electrónico en nano-dispositivos, en particular os FinFETs e nanofíos de porta completa ('gate-all-around nanowires') e o seu modelado e simulación usando o modelo arrastre-difusión con elementos finitos 3d e a aproximación de Montecarlo.

Actualmente son investigador posdoutoral do CiTiUS na Universidade de Santiago de Compostela, e o meu traballo está enfocado nos estudos de variabilidade dos nanodispositivos, os transistores de efecto de campo de tunelización e a computación paralela e distribuída.

## CONTACTO

**E-mail:**

daniel.nagy@usc.es

**Espazo:**

Despacho 108

**Teléfono:**

+34 8818 16430

**Identificadores de investigación:**

ORCID  
ResearcherID  
Google Scholar

## PUBLICACIONES

*Impact of Gate Edge Roughness Variability on FinFET and Gate-All-Around Nanowire FET*  
IEEE Electron Device Letters, 2019

*Drift-Diffusion Versus Monte Carlo Simulated ON-Current Variability in Nanowire FETs*  
IEEE Access, 2019

*Impact of threshold voltage extraction methods on semiconductor device variability*  
Solid-state Electronics, 2018

Ver  
todas